

**ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID CIRCUITS**  
**COMPOSANTS ACTIFS POUR CIRCUITS HYBRIDES**



**NPN planar power transistors (chips)**

*Transistors de puissance planar (pastilles)*

Type Type	$V_{CBO}$ (V)	$V_{CEO}$ (V)	$I_{CM}$ (A)	$h_{21E}$	$V_{CE}$ (V)	$I_C$ (mA)
				min - max		
J.2N 2890	100	80	2	30 - 90	5	1
J.2N 2891	100	80	2	50 - 150	5	1
J.71 T2	80	60	2	30 - 90	2	1
J.72 T2	80	60	2	75 - 200	2	1

**NPN Homonase<sup>®</sup> power transistors (chips)**

*Transistors de puissance NPN homobase<sup>®</sup> (pastilles)*

Type Type	$V_{CBO}$ (V)	$V_{CEO}$ (V)	$I_C$ (mA)	$h_{21E}$	$V_{CE}$ (V)	$I_C$ (mA)
				min - max		
J.2N 3054	90	55	4	25 - 100	4	0,5
J.2N 3055	100	60	15	20 - 70	4	4

**PNP epitaxial base power transistors (chips)**

*Transistors de puissance PNP à base épitaxiée (pastilles)*

Type Type	$V_{CBO}$ (V)	$V_{CEO}$ (V)	$I_C$ (mA)	$h_{21E}$	$V_{CE}$ (V)	$I_C$ (mA)
				min - max		
J.BDX 14	- 90	-55	- 4	25 - 100	-4	-0,5
J.BDX 18	-100	-60	-15	20 - 70	-4	-4